

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/ Nein
Publication in the Official Journal	Yes/ No
Publication au Journal Officiel	Oui/ Non

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 32/84

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 80400098.2

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 0014149

Bezeichnung der Erfindung: **Générateur de tension de référence et circuit de**
Title of invention: **mesure de la tension de seuil de transistor MOS,**
Titre de l'invention : **applicable à ce générateur de tension de référence**

Klassifikation / Classification / Classement : G 05 F3/20

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 6 août 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : Commissariat à l'Energie Atomique

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant:

Stichwort / Headword / Référence : Redéfinition d'une invention sur la base de la
description et des dessins

EPÜ / EPC / CBE Art. 83, 123 (2)

*"Exposé de l'invention" - "présence d'un élément
indispensable"*

Leitsatz / Headnote / Sommaire

1. Le fait que certains éléments d'une invention indispensables à son fonctionnement ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ni dans le dessin représentant l'invention revendiquée ni enfin dans la partie de la description s'y référant, n'implique pas obligatoirement que l'invention ne soit pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier ne puisse l'exécuter, comme l'exige l'Article 83 CBE.
2. L'homme du métier peut reconstruire l'invention à partir d'un principe exposé dans la description qui montre la présence indispensable d'un élément représenté non sur la figure de l'invention revendiquée, mais sur une autre figure de la demande, à condition de ne pas faire appel à des renseignements complémentaires et de ne pas faire preuve d'activité inventive. Dans ce cas l'Article 123(2) CBE n'est pas applicable.



N° du recours: T 32 / 84

DECISION

de la Chambre de recours technique 3.5.1

du 6 août 1985

Requérante : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Etablissement de Caractère Scientifique, Technique et
Industriel
31/33, rue de la Fédération
75015 Paris

Mandataire : MONGREDIEN André et al,
BREVATOME
25, rue de Ponthieu
75008 Paris

Décision attaquée : Décision de la division d'examen 062 de l'Office européen
des brevets du 26 septembre 1983 par laquelle la demande
de brevet n° 80 400 098.2 a été rejetée conformé-
ment aux dispositions de l'article 97 (1) CBE

Composition de la Chambre :

Président : G. Korsakoff
Membre : P. van den Berg
Membre : F. Benussi

EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS

1. La demande de brevet européen n° 80 400 098.2, déposée le 22 janvier 1980, publiée sous le numéro 0 014 149 et revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur du 26 janvier 1979, a été rejetée par décision de la Division d'examen 62 du 26 septembre 1983.

Cette décision a été prise sur la base des revendications 1-5, remises avec la lettre du 6 octobre 1982.

2. La Division d'examen a exposé dans cette décision que l'invention n'est pas décrite dans les pièces de la demande de manière telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter au sens de l'article 83 de la CBE.
3. La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 18 novembre 1983 et adressé à l'OEB un mémoire parvenu le 16 janvier 1984 exposant les motifs de ce recours.
4. Elle maintient sa demande sans modification dans la forme où elle avait été jugée par la Division d'examen ainsi que les revendications 1-5 remises avec la lettre du 6 octobre 1982.

Les pièces suivantes ont été retenues par la Chambre :

- la description, pages 2-13, remises lors du dépôt de la demande et la page 1, remise avec la lettre du 06.10.82,
- les revendications 1 à 5, remises avec la lettre du 06.10.82,
- les dessins, feuilles 1/3-3/3 remis lors du dépôt.

.../...

Les revendications sont rédigées comme suit :

1. Générateur de tension de référence comprenant deux transistors T'_1 et T'_2 de type de MOS, réalisés sur le même substrat, caractérisé en ce que les canaux de ces transistors ayant pour longueurs respectives L_1 et L_2 et pour largeurs respectives Z_1 et Z_2 , l'un des transistors T'_2 présente un canal dont une dimension et une seule est du même ordre de grandeur que la dimension correspondante de l'extension, par rapport à la source (S'_2) et au drain (D'_2) de ce transistor, de la zone de charge d'espace apparaissant autour de cette source et de ce drain lorsque le transistor fonctionne, l'autre dimension étant grande par rapport à la dimension correspondante de ladite extension de zone de charge d'espace, l'autre transistor T'_1 présentant un canal dont les deux dimensions sont grandes vis-à-vis de la dimension de l'extension de zone de charge d'espace correspondante, et en ce qu'il comprend des moyens pour fixer la tension commune (VBS) source-substrat des transistors T'_1 et T'_2 dont les sources (S_2, S'_2) sont réunies à un point commun (S), des moyens pour effectuer la différence des tensions de seuils des transistors T'_1 et T'_2 par mesure de la différence des tensions respectives grille-source des transistors T'_1 et T'_2 , ces moyens comprenant un condensateur (C') dont les deux bornes sont reliées respectivement à un premier point (D') qui est commun à la grille (T'_2) et au drain (D'_2) du transistor (T'_2) et à un second point (D'') qui est commun à la grille (T'_1) et au drain (D'_1) du transistor T'_1 par l'intermédiaire de deux interrupteurs (I_3, I'_3) de commande de charge et de décharge, les premier et second points (D', D'') communs étant réunis à une source de tension continue (V'_1), respectivement par l'intermédiaire de deux interrupteurs (I''_1 et I'_1) de mise sous tension, de sorte que les deux interrupteurs (I_3, I'_3) de charge et de décharge et les deux interrupteurs (I''_1 et I'_1) de mise sous tension étant fermés, chacune des armatures du condensateur (C') se charge au potentiel de la source (V'_1), et de sorte que les interrupteurs (I''_1 et I'_1) de mise sous tension étant ouverts et les interrupteurs (I_3, I'_3) de commande de charge et de décharge étant fer-

més, les armatures du condensateur se déchargent dans les transistors T'_2 et T'_1 , jusqu'à ce que la différence de potentiel disponible aux bornes de ce condensateur (C') égale la différence des tensions de seuil des transistors T'_1 et T'_2 , la différence des tensions de seuil des transistors T'_2 et T'_1 étant disponible aux bornes du condensateur (C') respectivement par l'intermédiaire de deux interrupteurs de sortie (I_2, I'_2) qui sont fermés après ouverture des interrupteurs (I_3, I'_3) de commande de charge et de décharge, lorsque la différence de potentiel aux bornes du condensateur (C') égale la différence des tensions de seuil des transistors T'_2 et T'_1 .

2. Générateur de tension de référence selon la revendication 1, caractérisé en ce que les interrupteurs (I_3, I'_3) de charge et de décharge, les interrupteurs (I'_1, I''_1) de mise sous tension et les interrupteurs de sortie (I_2 et I'_2) sont des transistors MOS dont les grilles sont reliées à des moyens de commande (Φ_3) pour rendre conducteurs les transistors (I_3 et I'_3) de commande de charge et de décharge et les transistors de mise sous tension (I'_1, I''_1), pendant un temps suffisant pour charger les armatures du condensateur (C') au potentiel de la source (V'_1), puis pour bloquer les transistors (I'_1, I''_1) de mise sous tension pour que les armatures du condensateur (C') se déchargent dans les transistors T_2 et T'_1 , jusqu'à ce que la différence de potentiel à ses bornes égale la différence des tensions de seuil des transistors T'_2 et T'_1 , puis pour rendre conducteurs les transistors (I_2, I'_2) de sortie lorsque cette différence des tensions de seuil est atteinte, cette tension étant disponible entre les sources de ces transistors (I_2, I'_2) de sortie dont les drains sont reliés aux bornes du condensateur (C'), les drains des transistors T'_2 et T'_1 étant reliés respectivement aux drains des transistors (I_3, I'_3) de charge et de décharge dont les sources sont reliées à ladite source de tension continue (V'_1).

3. Générateur de tension de référence selon la revendication 2, caractérisé en ce que la source de l'un des transistors de sortie (I'_2) est reliée à des moyens pour porter cette source à un potentiel (V_0) prédéterminé de polarisation par rapport au potentiel du substrat des transistors T'_2 et T'_1 .
4. Générateur de tension de référence selon la revendication 3, caractérisé en ce que la longueur L_1 du T'_1 est supérieure à 30 et que la longueur L_2 ou la largeur Z_2 du canal de T'_2 est inférieure à 5 .
5. Générateur de tension de référence selon la revendication 4, caractérisé en ce que le condensateur (C') et les transistors MOS sont réalisés sous forme de circuit intégré sur substrat.
5. Dans son mémoire de recours, la requérante soutient que l'invention est exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme de métier puisse l'exécuter.
6. Exposé plus détaillé de la procédure devant la Division d'examen :

Au dépôt, la demande comprenait les revendications 1-9. Dans sa première notification du 12.08.82, l'examineur a fait entre autres objections la remarque suivante (voir page 2, alinéa 3) "il semble que le circuit représenté à la figure 5 ne fonctionne pas comme il est décrit à la page 12, lignes 16 à 24. En effet, si les interrupteurs I'_1 , I''_1 , I_3 et I'_3 sont fermés, les plots du condensateur sont au même potentiel et la charge ne peut avoir lieu".

.../...

Dans sa réponse du 06.10.82, la requérante a présenté une nouvelle rédaction de la page 1 ainsi que de nouvelles revendications numérotées 1 à 5 pour remplacer les revendications d'origine.

Dans sa notification du 12.01.83, l'examineur a renouvelé son objection sur l'impossibilité de fonctionner du circuit représenté à la figure 5 en précisant que : "Dans la communication du 12.08.82 (page 2, alinéa 3) il a déjà été expliqué que le circuit représenté à la figure 5 faisant maintenant l'objet de la revendication 1 ne fonctionnait pas. Pour cette raison, l'invention définie dans la revendication 1 ne satisfait pas aux articles 52 et 57."

Dans sa réponse du 20.01.83, la requérante a contesté ce point de vue en affirmant que "les transistors T'_1 et T'_2 présentaient des tensions de seuil différentes, permettant au condensateur de se charger et que cette différence des tensions de seuil et la charge du condensateur C' étaient en fait les points essentiels du générateur de l'invention".

Dans sa notification du 16.06.83, l'examineur concentrait son examen une fois de plus sur le fonctionnement du circuit représenté à la figure 5 de la demande. Il soutenait que ce circuit ne peut certainement pas fonctionner comme décrit sans condensateurs additionnels et que la figure n'indique aucune capacité autre que le condensateur C' . Il en concluait que l'objet de la demande, à savoir la génération d'une tension de référence, n'était pas réalisable avec le circuit proposé et que par conséquent l'invention n'était pas suffisamment décrite dans les pièces de la demande pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter au sens de l'article 83 de la CBE.

Dans sa réponse du 08.07.83, le demandeur exposait le fonctionnement du circuit en cause, en précisant la chronologie de l'ouverture et de la fermeture des transistors-interrupteurs sous l'influence des signaux de commande ϕ_1 , ϕ_2 et ϕ_3 .

Le 26.09.83, la Division d'examen rejetait la demande au motif unique du non fonctionnement de la figure 5 et indiquait que le texte ne comportait aucune référence à une capacité autre que (C').

II. MOTIFS DE LA DECISION

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE.
2. La Division d'examen a considéré que le circuit, objet de la demande, ne permettait pas d'obtenir une tension de référence et a, en conséquence, pris une décision de rejet fondée uniquement sur l'article 83 de la CBE (page 4, dernier alinéa).

Elle ne s'occupe en fait que du prétendu non fonctionnement du circuit décrit à la figure 5 de la demande et ne se prononce pas sur les revendications.

La requérante demande la délivrance d'un brevet sur la base du texte actuel des revendications (page 1, lignes 2 et 3 du mémoire).

En lisant la revendication 1, il est clair que c'est l'objection basée sur l'article 83 de la CBE, telle qu'elle est exposée dans la décision de rejet, qui est décisive.

Afin d'arriver à une décision concernant ce recours, la Chambre de recours estime nécessaire de réexaminer si la demande déposée initialement apporte suffisamment d'informations à l'homme de métier pour qu'il puisse réaliser l'invention dans le sens de l'article 83.

3. Dans ce but, il apparaît nécessaire d'examiner le fonctionnement du circuit de la figure 5, ainsi que la description déposée. Ce circuit ainsi que son fonctionnement sont revendiqués dans la présente revendication 1.

Les pages 12 et 13 de la description décrivent la génération de la tension de référence dans le circuit de la figure 5 quand on

applique en trois étapes les signaux de commutation ϕ'_1 , ϕ_2 et ϕ_3 . Ces étapes sont résumées ici dans la terminologie de la demande et désignées par les lettres a, b et c :

- a) première étape : les interrupteurs I' , I'' , I_3 , I'_3 sont fermés. Les interrupteurs I_2 et I'_2 sont ouverts pendant le temps de fermeture des interrupteurs I'_1 , I''_1 , I_3 , I'_3 . Il en résulte que les armatures du condensateur C' , grâce à la fermeture de ces interrupteurs, se chargent et prennent le potentiel V'_1 de la source de tension ;
- b) deuxième étape : les interrupteurs I_3 et I'_3 restent fermés, tandis que les interrupteurs I'_1 , I''_1 , I_2 et I'_2 sont ouverts. Il en résulte que le condensateur C' se décharge à travers les transistors T'_2 et T'_1 ; cette décharge s'arrête lorsque la tension $V_{D'_1}-V_S$ entre la grille et la source du transistor T'_1 est égale à la tension du seuil $V_{T'_1}$, de ce transistor et que la tension $V_{D'_2}-V_S$ entre la grille et la source du transistor T'_2 est égale à la tension de seuil $V_{T'_2}$ de ce transistor. Il en résulte que la différence de potentiel $V_{D'_1}-V_{D'_2}$ entre les grilles ou les drains des transistors T'_1 et T'_2 est égale à la différence des tensions de seuil $V_{T'_1}-V_{T'_2}$ des deux transistors T'_1 et T'_2 .
- c) troisième étape : les interrupteurs I'_1 , I''_1 , I_3 , I'_3 sont ouverts tandis que les interrupteurs I_2 , I'_2 sont fermés. La différence de tension de seuil $V_{T'_1}-V_{T'_2}$ apparaît entre les bornes S' et S'' .

La Chambre doute que dans l'étape (a) les deux électrodes du condensateur (C') soient au même potentiel. En effet, en fermant les interrupteurs I' et I'' , on réalise un montage parallèle entre la borne au potentiel V'_1 et la borne S , la première branche comprenant en série les deux transistors I'_1 et T'_2 à

l'état passant la seconde les transistors I''_1 et T'_1 également à l'état passant. Ces transistors ayant des caractéristiques et des tensions de seuil différentes, les deux branches devraient être traversées par des courants différents. Il en résulte que les branches constituant des diviseurs de tension traversés par des courants différents, les potentiels des points D' et D'' doivent être différents. La Chambre considère que l'essentiel dans le fonctionnement du circuit est le fait que dans l'étape b), on ouvre les interrupteurs I'_1 et I''_1 , tout en laissant fermés les interrupteurs I_3 et I'_3 .

Dans ces conditions, en admettant que le condensateur (C') a été chargé par la différence de potentiel non nulle entre les points D' et D'' , il pourrait se décharger dans le circuit en série comprenant I_3 , T'_2 , T'_1 , I'_3 .

Les transistors T'_1 et T'_2 ayant des tensions de seuil différentes, l'un d'eux (et ce serait celui ayant la tension de seuil la plus élevée, T'_1 par exemple) sera bloqué avant l'autre.

A ce moment, il n'y aurait plus de contact dans le circuit en série, la décharge du condensateur C' serait terminée, la tension et le courant source drain s'annuleraient.

Dans ce cas, à la fin de la deuxième étape (b), il existerait une différence de potentiel entre les deux électrodes du condensateur C' égale à la tension de seuil la plus élevée des deux transistors T'_1 et T'_2 .

Il est donc impossible d'obtenir de cette manière une tension de référence $V_{T'_1}$ et $V_{T'_2}$ aux bornes du condensateurs C' . Cette conclusion justifie la décision de la Division d'examen suivant laquelle le circuit en cause ne fonctionne comme prévu que s'il y est adjoint d'autres moyens tels que des capacités supplémen-

taires qui permettent de maintenir à leur valeur de seuil les tensions grille-source des transistors T'_1 et T'_2 .

Il semble important que dans la première étape (a), la fermeture des interrupteurs I'_1 et I'' , rende les transistors T'_1 et T'_2 passants avec des tensions grille-source supérieures à leur valeur de seuil et que dans la deuxième étape (b), l'ouverture des interrupteurs I'_1 et I'' , fasse décroître les tensions grille-source des transistors T'_1 et T'_2 et par conséquent, leur courant grille-source jusqu'à leur blocage respectif qui n'est probablement pas simultané.

La condition nécessaire que doit remplir ce circuit pour pouvoir fonctionner est que la tension grille-source des deux transistors qui est égale à la tension de seuil reste constante, pendant un temps suffisamment long pour que le potentiel de chaque électrode du condensateur (C') s'égalise avec celui de la grille du transistor à laquelle cette électrode est reliée par l'un des interrupteurs I_3 et I'_3 .

L'invention permet donc de disposer d'une tension de référence égale à la différence des vraies tensions de seuil des deux transistors T'_1 et T'_2 . Ce principe ne se retrouve dans aucun des documents cités dans le rapport de recherche.

4. L'idée d'utiliser la vraie tension de seuil d'un transistor est exposée dans le texte de la demande relatif à la figure 4. On y trouve une explication détaillée qui s'applique également à la figure 5 suivant laquelle, l'interrupteur I_1 n'est fermé que pendant un intervalle de temps assez court Δt puis est ouvert, ce qui permet après un certain temps d'utiliser la tension de seuil de T_2 comme tension de référence.

Il est également clair que le condensateur (C) est indispensable à ce circuit, parce que c'est grâce à lui qu'après l'ouverture

de l'interrupteur I_1 subsiste une tension entre d'une part la grille ou le drain, c'est-à-dire le point A et d'autre part la source, c'est-à-dire le point E du transistor T_2 ; cette tension étant, au moment de l'ouverture de l'interrupteur I_1 plus élevée que la tension de seuil du transistor T_2 , le condensateur (C) va se décharger jusqu'à ce que sa tension soit devenue égale à la tension de seuil du transistor T_1 .

La différence de potentiel aux bornes du condensateur (C) disponible comme tension de référence, est aussi égale à la tension de seuil du transistor T_2 .

5. Dans le texte déposé, le but de l'invention est exposé à la page 2, lignes 13 à 21 et son objet est défini à la page 2, ligne 22 jusqu'à la page 3, ligne 5. Dans ce dernier passage, il est clair que l'invention a pour objet des moyens "pour effectuer la différence des tensions de seuil des transistors T'_1 et T'_2 , cette différence de tensions de seuil représentant ladite tension de référence", ainsi que le formule la revendication 1, initialement déposée.

- (i) Cela prouve que dans sa version originale, la demande avait pour objet la génération d'une tension de référence, égale à la différence non nulle des tensions de seuil de deux transistors, spécifiquement sélectionnées dans ce but.

Le déposant ayant utilisé la notation T'_1 et T'_2 dans son exposé de l'objet de la demande aux pages 2 et 3, il est clair que c'est la figure 5 de cette demande qui est la seule contenant ces symboles T'_1 et T'_2 qui illustre son objet.

- (ii) Pour expliquer le fonctionnement de ce circuit où on génère les tensions de seuil de deux transistors (T'_1 et

T'₂), la demanderesse commence par la génération de la tension de seuil d'un seul transistor (T₁ dans la figure 4). Dans ce circuit, le condensateur (C) est indispensable, comme le montrent la description et les explications antérieures. En poursuivant la lecture de la demande, on note à la page 11 lignes 33 à 37 la remarque suivante :

"Le fonctionnement du générateur de tension de référence représenté sur la figure 5 sera maintenant mieux compris à l'aide des explications qui vont suivre. Ce générateur met en oeuvre deux circuits de mesure de tensions de seuil, décrits précédemment, en référence aux figures 4a et 4b".

La Chambre de recours estime que de même que le circuit du transistor T'₁ de la figure 5 comprend une capacité supplémentaire équivalente à la capacité (C) de la figure 4a, de même le circuit du transistor T'₂ doit comprendre sa capacité propre équivalente à C.

(iii) La Chambre de recours estime que l'homme de métier qui a lu la demande et notamment le paragraphe lignes 33 à 37 de la page 11 sera étonné de ne pas trouver dans la figure 5 en plus de la capacité ~~2~~ des capacités additionnelles analogues à celle de la figure 4a. Il trouvera ensuite que le circuit de la figure 5 ne peut fonctionner que s'il tient compte de la remarque à la page 11, lignes 33 à 37 vue plus haut qui entraîne la présence de capacités supplémentaires équivalentes à la capacité C de la figure 4a.

(iv) La Chambre de recours considère que compte tenu des considérations vues plus haut, la demande contient suffisamment d'indications pour permettre à l'homme de métier d'avoir une idée complète de l'invention et de la réaliser.

- (v) L'omission par le demandeur des capacités supplémentaires dans la description et la figure 5 ne doit pas être interprétée contre lui étant donné que l'enseignement de la demande est pour l'homme de l'art dénué de toute ambiguïté.
6. Dans les paragraphes antérieurs 3 à 5, la Chambre a examiné la recevabilité au sens de l'article 83 CBE de la demande dans son texte d'origine. Elle n'a pas tenu compte des informations, arguments et explications présentés par l'examineur ou le demandeur.

Ce qu'elle estime possible étant donné que la demande comme vu plus haut contient assez d'informations pour que l'invention puisse être pratiquement mise en oeuvre.

Elle n'a donc pas à se préoccuper des incidences de l'article 123(2) CBE.

7. Les capacités supplémentaires dont il est question sont par exemple les capacités parasites présentes dans un circuit intégré et inhérentes à ce circuit.

L'homme de l'art en est parfaitement averti et sait par ailleurs qu'il est possible de donner à ces capacités une valeur bien déterminée au cours de la fabrication des circuits. Il se sert de cette connaissance pour la conception desdits circuits. On peut se reporter pour plus d'informations aux pages 30 et 31 de l'ouvrage de H. Lilien, communiqué par le requérant, intitulé "Principes et applications des circuits intégrés" (1972) où de telles capacités sont appelées "capacités de structure". La demande donne une indication dans ce sens puisque à la page 9, lignes 31 à 33, elle explique que "le transistor T_2 de petite géométrie, le transistor MOS ~~X~~ ainsi que le condensateur C, peuvent être réalisés sous forme de circuit intégré sur substrat semi-conducteur".

I, 9

8. Ces remarques ne doivent pas cacher les déficiences du texte que seule une analyse attentive permet de pallier. On peut citer l'exemple suivant :

A la page 12, lignes 20 à 24 du texte, le rédacteur écrit que pendant la première étape, les armatures du condensateur C' se chargent et prennent le potentiel V'_1 de la source de tension, mais il ajoute trois lignes plus loin aux lignes 27 à 29, que pendant la deuxième étape, le condensateur C' se décharge à travers les transistors T'_2 et T'_1 .

La première phrase signifie que les deux bornes du condensateur C' sont au même potentiel, donc que la charge de ce condensateur C' est nulle. C' ne peut donc se décharger à travers les transistors T'_1 et T'_2 contrairement à ce que dit la deuxième phrase. Cette erreur du rédacteur de la demande explique que la Division d'examen ait conclu que le circuit de la figure 5 ne pouvait fonctionner comme prévu.

Il convient de signaler que ces capacités additionnelles existent soit entre la grille et la source du transistor (voir figure 4a) soit entre grille et substrat, soit comme la grille est connectée au drain entre drain et source ou entre drain et substrat.

La capacité entre drain et substrat peut dans le circuit de la figure 5 être remplacée par la capacité entre une électrode du condensateur C' et le substrat, sans gêner le fonctionnement. Ceci est dû à ce que pendant la décharge de cette capacité jusqu'à la tension de seuil du transistor considéré, les interrupteurs I_3 et I'_3 sont fermés.

.../...

9. La décision de rejet de la Division d'examen est basée sur une non conformité de la demande avec l'article 83 BE. Ce motif étant suffisant, la Division d'examen n'avait pas à poursuivre la procédure en ce qui concerne les autres conditions de brevetabilité (nouveauté et activité inventive). Le fait que la seconde notification du 12.01.83 fait référence aux articles 52 et 57 CBE ne signifie pas que la demande a été examinée en fonction d'autres critères que ceux de l'article 83 CBE.

En conséquence, vu que

- le motif du rejet basé sur l'article 83 CBE a été reconnu inexact,
- la demande n'a pas encore été examinée quant aux critères de brevetabilité autres que celui de l'article 83,
- le demandeur est en droit de réclamer un traitement équitable,

la Chambre de recours renvoie la demande à la première instance conformément à l'article 111(1) CBE.

.../...

DISPOSITIF

Pour ces motifs,

il est statué comme suit,

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la Division d'examen avec mission de poursuivre l'examen de la demande.

Le Greffier

B A Norman

Le Président

G Korsakoff